

Спосіб усунення включень другої фази з кристалів на основі CdTe, що включає термообробку зразка в парі кадмію в вакуумованій запаяній кварцовій ампулі, який відрізняється тим, що термообробку проводять при температурі зразка 1100 К і джерела пари кадмію 1070 К протягом 2 годин з наступним програмованим охолодженням зі швидкістю 5 К/хвилина.